

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年 5月16日

出願番号 Application Number: 特願2003-138496

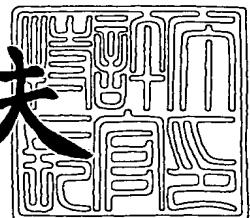
[ST. 10/C]: [JP2003-138496]

出願人 Applicant(s): 株式会社荏原製作所

2003年 9月 8日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 PEB-0013
【提出日】 平成15年 5月16日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 B24B 37/04
【発明者】
【住所又は居所】 東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社荏原製作所
内
【氏名】 廣川 一人
【発明者】
【住所又は居所】 東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社荏原製作所
内
【氏名】 中井 俊輔
【発明者】
【住所又は居所】 東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社荏原製作所
内
【氏名】 大田 真朗
【特許出願人】
【識別番号】 000000239
【氏名又は名称】 株式会社荏原製作所
【代理人】
【識別番号】 230104019
【弁護士】
【氏名又は名称】 大野 聖二
【電話番号】 03-5521-1530

【選任した代理人】

【識別番号】 100106840

【弁理士】

【氏名又は名称】 森田 耕司

【電話番号】 03-5521-1530

【選任した代理人】

【識別番号】 100113549

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 守

【電話番号】 03-5521-1530

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 185396

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 基板研磨装置および基板測定装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板が押圧される研磨テーブルと、

前記基板の膜測定のために、前記研磨テーブルから前記基板に測定光を投光し
、前記基板から反射光を受光する投受光装置と、

前記測定光の投光箇所に前記測定光および前記反射光が透過する測定用流体を
供給する流体供給装置と、

を備え、前記流体供給装置は、前記測定用流体として、研磨のスラリに用いられる溶媒を供給することを特徴とする基板研磨装置。

【請求項 2】 前記溶媒は、シリカスラリのアルカリ性溶媒であることを特徴とする請求項 1 に記載の基板研磨装置。

【請求項 3】 前記溶媒は、セリアスラリの界面活性剤溶液であることを特徴とする請求項 1 に記載の基板研磨装置。

【請求項 4】 基板が押圧される研磨テーブルを有する基板研磨装置に設けられ、前記基板の膜測定を行う基板測定装置であって、

前記研磨テーブルは測定用流体を供給する流体供給装置を有し、前記流体供給装置は、前記測定用流体として、研磨のスラリに用いられる溶媒を供給することを特徴とする基板測定装置。

【請求項 5】 基板が押圧される研磨テーブルと、

前記基板の膜測定のために、前記研磨テーブルから前記基板に測定光を投光し
、前記基板から反射光を受光する投受光装置と、

前記測定光の投光箇所に前記測定光および前記反射光が透過する測定用流体を
供給する流体供給装置と、

を備え、前記流体供給装置は、前記測定用流体として、研磨のスラリと比べて
高い粘度を有する高粘度流体を供給することを特徴とする基板研磨装置。

【請求項 6】 基板が押圧される研磨テーブルを有する基板研磨装置に設けられ、前記基板の膜測定のために、前記研磨テーブルから前記基板に測定光を投光し、前記基板から反射光を受光する基板測定装置であって、

前記測定光の投光箇所に前記測定光および前記反射光が透過する測定用流体を供給する流体供給装置を有し、前記流体供給装置は、前記測定用流体として、研磨のスラリと比べて高い粘度を有する高粘度流体を供給することを特徴とする基板測定装置。

【請求項 7】 基板が押圧される研磨テーブルと、
前記基板の膜測定のために、前記研磨テーブルから前記基板に測定光を投光し
、前記基板から反射光を受光する投受光装置と、
前記測定光の投光箇所に前記測定光および前記反射光が透過する測定用流体を
供給する流体供給装置と、
を備え、前記流体供給装置は、前記測定用流体として気体を供給することを特
徴とする基板研磨装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、光を利用する基板測定装置を備えた基板研磨装置に関し、特に、基
板測定が研磨プロセスへ与える影響を低減する技術に関する。

【0002】

【従来の技術】

半導体製造プロセスにおいては、基板表面を平坦かつ鏡面にするために基板研
磨装置が用いられている。基板研磨装置は、回転する研磨テーブルを有しており
、研磨テーブルの研磨面に基板が押し付けられる。そして、研磨中に基板上の膜
の測定を行う装置として、光を利用する基板測定装置が提案されている。例えば
、膜厚を測定し、膜厚に基づいて研磨の終了時点を判定することができる。

【0003】

この種の基板測定装置の一つとして、水流タイプの装置が提案されている。例
えば、特開2001-235311号公報（特許文献1）は、研磨テーブル内に
水供給路を有する基板測定装置を開示している。水供給路の出口が研磨面に設け
られており、水供給路を通じて水が基板に噴射される。水流内には、2本の光フ
ァイバが配置されている。一方の光ファイバを介して測定光が基板に投光され、

他方の光ファイバに基板からの反射光が受光される。そして、反射光に基づいて膜厚が計算される。

【0004】

【特許文献 1】

特開 2001-235311 号公報（第3、4頁、図1）

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

水流式の基板測定装置は、研磨パッドの貫通穴に水を供給しており、これにより、研磨テーブルと基板の間から貫通穴に流入してくるスラリーを希釈でき、また、基板に付着しているスラリを洗浄できる。このようにして、測定へのスラリの影響が低減され、要求される測定性能が確保される。

【0006】

しかしながら、測定性能の要求を満たすためには、大量の水の供給が求められる。大量の水を供給すると、水が研磨テーブル上の研磨面へ流出してスラリを希釈し、スラリの希釈が研磨性能に影響を及ぼす可能性がある。このように、従来は、測定性能を考慮して水量を増大すると研磨性能が影響を受けてしまい、測定性能と研磨性能にはトレードオフの関係があった。

【0007】

本発明は上記背景の下でなされたものであり、測定性能を確保しつつ、研磨性能への測定用流体の影響を低減可能な基板研磨装置を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明の第1の態様において、基板研磨装置は、基板が押圧される研磨テーブルと、前記基板の膜測定のために、前記研磨テーブルから前記基板に測定光を投光し、前記基板から反射光を受光する投受光装置と、前記測定光の投光箇所に前記測定光および前記反射光が透過する測定用流体を供給する流体供給装置と、を備え、前記流体供給装置は、前記測定用流体として、研磨のスラリに用いられる溶媒を供給する。ここで、溶媒は、スラリの非砥粒成分である。本発明において、基板と研磨テーブルは相対的に押圧されればよい。

したがって、典型的には基板が研磨テーブルへ向けて付勢されるが、本発明はこれに限定されない。

【0009】

本発明によれば、測定用流体としてスラリの溶媒が供給されるので、測定用流体が研磨テーブルに流出してスラリと混ざったとしても、スラリの希釈による研磨性能への影響を低減できる。本発明は、スラリそのものの透明度が低い場合でもスラリの溶媒の透明度が比較的高いことに着目している。そして、スラリの溶媒を使うことで測定能力を確保しつつ、上記のように研磨性能への測定用流体の影響も低減している。

【0010】

前記溶媒はシリカスラリのアルカリ性溶媒でもよい。シリコン酸化膜（SiO₂）の研磨用のシリカスラリは、リムーバルレート（除去速度）を確保するために、溶媒としてアルカリ性溶媒（pH 10～11）を含有している。アルカリ性溶媒が純水で希釈されると、リムーバルレートが低下する。本発明では、シリカスラリのアルカリ性溶媒を測定用流体として用いることにより、リムーバルレートへの影響を低減できる。アルカリ性溶媒の種類は、例えば、KOHまたはNH₄OHである。

【0011】

また、前記溶媒はセリアスラリの界面活性剤溶液でもよい。シリコン酸化膜（SiO₂）またはSTIウェハの研磨用のセリアスラリは、溶媒として界面活性剤溶液を含有しており、これによりリムーバルレートを低く抑え、段差特性を確保している。界面活性剤が純水で希釈されると、レート上昇が起こり、段差特性が悪化する可能性がある。本発明では、セリアスラリの界面活性剤溶液を測定用流体として用いることにより、リムーバルレートおよび段差特性への影響を低減できる。界面活性剤は、好ましくは陽イオン界面活性剤である。陽イオン界面活性剤としては、ポリカルボン酸アンモニウム等が挙げられる。

【0012】

好ましくは、流体供給装置の供給路を構成する部材は、耐薬品性の高い材料で構成される。例えば、樹脂材またはセラミックが適用される。供給路が、耐薬品

性の高い材料でコーティングされてもよく、これも上記構成に含まれる。本発明によれば、測定用流体として用いる溶媒による供給路部材の損傷が防止される。また、溶媒の影響で供給路部材から溶出する不純物による基板の汚染が防止される。好ましくは、測定光および反射光を導く部材、例えば光ファイバも同様に構成される。

【0013】

本発明の第2の態様において、基板研磨装置は、基板が押圧される研磨テーブルと、前記基板の膜測定のために、前記研磨テーブルから前記基板に測定光を投光し、前記基板から反射光を受光する投受光装置と、前記測定光の投光箇所に前記測定光および前記反射光が透過する測定用流体を供給する流体供給装置と、を備え、前記流体供給装置は、前記測定用流体として、研磨のスラリと比べて高い粘度を有する高粘度流体を供給する。高粘度流体は、典型的には液体であるが、液体に限定されない。高粘度流体はゾル等でもよく、また、ゲルも本発明では高粘度流体に含まれてよい。

【0014】

本発明によれば、高粘度流体が測定用流体として供給されるので、測定部位に流入するスラリの拡散を低減することができる。これにより、膜測定へのスラリの影響を低減し、測定性能を向上可能である。

【0015】

また、本発明によれば、測定用流体として高粘度流体を使うので、測定用流体の流出量を低減可能である。さらに、上記の拡散低減効果により測定性能が向上するので、水よりも少ない供給量で同等の測定性能を得ることが可能になり、この点でも測定用流体の流出量を低減可能と考えられる。そして、流出量の低減により、研磨性能への測定用流体の影響を低減できる。したがって、本発明も、測定性能を確保しつつ、研磨性能への測定用流体の影響を低減できる。

【0016】

本発明の第3の態様において、基板研磨装置は、基板が押圧される研磨テーブルと、前記基板の膜測定のために、前記研磨テーブルから前記基板に測定光を投光し、前記基板から反射光を受光する投受光装置と、前記測定光の投光箇所に前

記測定光および前記反射光が透過する測定用流体を供給する流体供給装置と、を備え、前記流体供給装置は、前記測定用流体として気体を供給する。

【0017】

本発明では、測定用流体として気体を用いることによりスラリが測定部位から好適に排除され、良好な測定性能が得られる。気体が流出してもスラリが希釈されないので、研磨性能への測定用流体の影響を低減でき、この点では、本発明も、測定性能を確保しつつ、研磨性能への測定用流体の影響を低減できる。気体は、例えば、空気、窒素または希ガスである。

【0018】

好ましくは、投光部材および受光部材が撥水性のある部材で構成される。投光部材および受光部材に撥水処理が施されてもよい。これにより、投光部材および受光部材にスラリが付着したとき、付着したスラリが容易に排除される。

【0019】

以上に、本発明の各種の態様を説明したが、本発明は上記の基板研磨装置に限定されない。例えば、本発明の別の態様は、基板研磨装置に備えられる基板測定装置である。基板測定装置は、例えば、基板が押圧される研磨テーブルを有する基板研磨装置に設けられ、前記基板の膜測定を行う基板測定装置であって、前記研磨テーブルは測定用流体を供給する流体供給装置を有し、前記流体供給装置は、前記測定用流体として、研磨のスラリに用いられる溶媒を供給する。これにより、上述したように研磨性能への測定用流体の影響を低減する効果が得られる。

【0020】

また、本発明の別の態様は、上記の基板研磨装置を備えた基板処理装置である。また、本発明の別の態様は、基板研磨装置による基板研磨方法および基板測定装置による基板測定方法である。

【0021】

【発明の実施の形態】

「実施の形態1」

以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。

【0022】

図1は、本実施の形態の基板研磨装置を示している。基板研磨装置10は、いわゆる化学的機械的研磨（CMP:Chemical Mechanical Polishing）装置であり、研磨テーブル12とトップリング14を有する。研磨テーブル12の上面には、研磨面16を有する研磨パッド18が取り付けられている。トップリング14は、下面で基板20を支持しており、基板20と共に回転する。そして、トップリング14は、研磨テーブル12の中心から離れた位置で基板20を研磨パッド18に押し付ける。研磨パッド18と基板20の間には研磨用のスラリが供給される。スラリは、スラリ容器200からスラリ供給路202を通って供給される。基板20は、スラリの存在下で、研磨テーブル12の研磨パッド18に押し付けられた状態で回転し、さらに、研磨テーブル12が回転し、これにより基板20が研磨される。

【0023】

基板研磨装置10は、基板20に形成された薄膜の研磨に用いられる。薄膜の厚さが所定の値になった時点で研磨が終了する。終了時点の判定を本実施の形態では、終点検知（end point detection）という。終点検知のために、基板研磨装置10は、以下に説明する膜厚測定装置22を備えている。

【0024】

膜厚測定装置22は、本発明の基板測定装置の一形態である。測定対象の膜は、例えば酸化シリコン膜である。膜厚測定装置22は、研磨テーブル12に内蔵されたセンサ24を有し、さらに、研磨テーブル12の下面に取り付けられた電源ユニット26、コントローラユニット28、光源ユニット30およびフォトメータユニット32を有する。

【0025】

電源ユニット26は、ロータリーコネクタ34を介して電力を受け取り、膜厚測定装置22の各構成に電力を供給する。コントローラユニット28は膜厚測定装置22の全体を制御する。光源ユニット30はセンサ24に測定光を供給し、測定光はセンサ24にて基板20に照射される。センサ24は、基板20からの反射光を受光し、フォトメータユニット32に送る。測定光および反射光の伝達部材は共に光ファイバである。フォトメータユニット32では、光信号が電気信号に変換される。

号に変換される。この電気信号がコントローラユニット28で処理される。

【0026】

コントローラユニット28は、ロータリーコネクタ34を介して光学的指標計算部36に接続され、光学的指標計算部36は光学的指標判定部38に接続されている。コントローラユニット28で処理された信号は光学的指標計算部36に送られ、光学的指標計算部36で膜厚、反射強度、スペクトル等の光学的指標が計算される。光学的指標判定部38は、膜厚等の光学的指標の判定を行い、そして、膜厚が所定の値に達したか否かの終点検知を行う。判定結果は、基板研磨装置10の全体を制御する研磨制御部40に送られる。

【0027】

膜厚測定装置22は、さらに、センサ24に測定用流体を供給するための供給路42と、センサ24から測定用流体を排出するための排出路44を有する。供給路42は、ロータリージョイント46を介して流体容器100に接続されている。供給路42上には測定用流体の強制供給のための供給ポンプ102が設置されている。また、排出路44は、測定室内の流体を排出するポンプ48に接続されている。ポンプ48により測定用流体が排出され、また、測定室に流入するスラリ等の研磨液も排出される。

【0028】

供給路42および排出路44は適当な配管等で構成される。供給路42および排出路44は、研磨テーブル12内に設けられたジャケットを含んでもよい。

【0029】

供給路42は、図示のように並列部50を有し、並列部50は主流路52および副流路54からなる。そして、主流路52および副流路54には供給制御弁56、58が設置されている。主流路52は、大流量の測定用流体の供給によってセンサ24で測定用流体を噴射するために用いられる。一方、副流路54にはオリフィス（図示せず）が設けられており、副流路54は低流量の測定用流体の供給に用いられる。低流量供給と噴射の切替のために、供給制御弁56、58が開閉される。

【0030】

さらに、排出路44には排出制御弁60が設置されている。排出制御弁60は、強制排出タイミングの制御のために使われる。排出制御弁60および供給制御弁56、58は電磁弁であり、図示されないが電磁弁ユニットを構成する。この電磁弁ユニットは、他のユニットと同じく研磨テーブル12の下面に取り付けられている。

【0031】

基板研磨装置10は、さらに、研磨テーブル12内に冷却用のウォータージャケット62を有する。ウォータージャケット62はロータリージョイント46を介して図示されない水タンクに接続されている。

【0032】

図2は、センサ24の構成例を示している。既に説明したように、研磨テーブル12に研磨パッド18が載せられており、研磨パッド18に基板20が接触する。研磨テーブル12には、供給路42および排出路44が並んで設けられている。そして、供給路42の供給口64および排出路44の排出口66が、研磨テーブル12の上面に位置している。研磨パッド18は貫通穴68を有しており、これにより、供給口64および排出口66が露出する。

【0033】

供給路42には、投光用光ファイバ70および受光用光ファイバ72が並んで配置されている。投光用光ファイバ70および受光用光ファイバ72は、光源ユニット30およびフォトメータユニット32（図1）に接続されている。そして、投光用光ファイバ70は、光源ユニット30から供給された測定光を基板20に照射する。受光用光ファイバ72は、基板20からの反射光を受光し、反射光をフォトメータユニット32へ伝える。

【0034】

上記のセンサ24では、測定用流体が、供給口64から供給され、排出口66から排出されている。貫通穴68の内部が測定用流体で満たされ、研磨用のスラリの貫通穴68への侵入が制限される。これにより、貫通穴68の内部が透明に保たれるので、測定光を使った膜測定が良好に行える。

【0035】

図3は、基板研磨装置10を備えた基板処理装置の全体構成を示している。基板処理装置80は、基板カセット保持部82、基板移動装置84および洗浄室86を基板研磨装置10と共に備えている。被研磨体である基板は、基板カセット保持部82から基板研磨装置10に送られる。そして、研磨後の基板は、洗浄室86で洗浄および乾燥され、基板カセット保持部82に戻される。

【0036】

また、基板処理装置80は、基板研磨装置10が設けられた部屋に、作業用窓88を有する。スラリはノズル90を通って研磨テーブル12へ供給される。ノズル90は、図1のスラリ供給管202を構成している。測定用流体は、図示されないが、研磨テーブル12へと下側から供給される。

【0037】

以上に、本実施の形態の基板研磨装置10の全体構成を、センサ24の構成と共に説明した。基板研磨装置10においては、スラリ供給路202（図1）がスラリ供給装置を構成しており、供給路42および排出路44（図1、図2）が測定用流体の供給装置および排出装置を構成している。また、投光用光ファイバ70および受光用光ファイバ72（図2）が、測定光の投光と反射光の受光を行う投受光装置を構成している。

【0038】

次に、本実施の形態の特徴的構成について説明する。本実施の形態では、流体容器100は、測定用流体として、スラリの溶媒を収容している。スラリの溶媒は、好ましくは、スラリと同じ種類で、同じ濃度の主成分溶媒である。この溶媒が、供給ポンプ102により送出され、供給路42を通ってセンサ24に供給される。

【0039】

溶媒は研磨パッド18の貫通穴68（図2）へと噴出される。溶媒は、研磨テーブル12と基板20の間から貫通穴68へと流入してくるスラリーを希釈する役割を果たす。また、溶媒は、基板20に付着しているスラリを洗浄する役割も果たす。このようにして、測定へのスラリの影響を低減し、要求される測定性能が確保できる。

【0040】

測定用流体である溶媒は、貫通穴68に大量に供給されるので、貫通穴68から流出し、基板20と研磨テーブル12の隙間へと流出する可能性がある。

【0041】

しかし、このような流出が発生したとしても、本実施の形態では、測定用流体として溶媒が用いられているので、以下に説明するように、研磨性能への悪影響が少ない。すなわち、溶媒が流出した場合、スラリの溶媒が増え、溶質である砥粒の濃度は薄くなる。しかし、溶媒が増えた程度では、研磨性能への影響は少ない。特に、水によりスラリが希釈される場合と比べると、研磨性能への影響は大幅に少ないといえる。

【0042】

このようにして、本実施の形態によれば、測定用流体としてスラリの溶媒が供給されるので、測定用流体が研磨テーブルに流出してスラリと混ざったとしても、スラリの希釈による研磨性能への影響を低減できる。本実施の形態は、スラリそのものの透明度が低い場合でも、砥粒を含まないスラリ溶媒の透明度が比較的高いことに着目している。そして、スラリの溶媒を使うことで測定能力を確保しつつ、上記のように研磨性能への測定用流体の影響も低減している。

【0043】

次に、スラリおよび溶媒の適当な組合せ例を説明する。シリコン酸化膜(SiO₂)を研磨するためにシリカスラリがスラリ容器から供給されるとする。この種のシリカスラリは、リムーバルレート(除去速度)を確保するために、溶媒としてアルカリ性溶媒(pH10～11)を含有している。そこで、このアルカリ溶液が測定用流体として用いられる。これにより、測定用流体の流出によるリムーバルレートへの影響を低減できる。アルカリ性溶媒の種類は、例えば、KOHまたはNH₄OHである。

【0044】

別の例では、シリコン酸化膜(SiO₂)またはSTIウェハを研磨するためセリアスラリが供給されるとする。セリアスラリは、溶媒として界面活性剤溶液を含有しており、これによりリムーバルレートを低く抑え、段差特性を確保し

ている。そこで、この界面活性剤溶液が測定用流体として用いられる。これにより、レート上昇および段差特性の悪化が抑えられ、研磨性能への影響を低減できる。

【0045】

界面活性剤は、好ましくは陽イオン界面活性剤である。セリアスラリのセリア粒子（セリア砥粒）は、光を吸収しやすい特性を有する。また、ゼータ電位でみると、セリア粒子の等電位点はpH7付近にあるので、セリア粒子は純水中では基板表面（SiO₂）に電気的に吸着しやすい。しかし、基板表面にpH7未満の陽イオン界面活性剤を噴射すれば、セリア粒子と基板表面に陽イオン界面活性剤が吸着するので、両者は電気的に反発しあう。したがって、セリア粒子は基板表面から除去されやすくなる。このようにして、基板表面のセリア粒子が減るので、反射光がより多く受光される。投受光のS/N比が改善され、測定性能の向上が図れる。

【0046】

本発明のスラリおよび溶媒は、上記に限定されない。例えば、金属膜研磨用のスラリの場合には、そのようなスラリと同じ種類、同じ濃度の溶媒が用いられる。溶媒は主に酸化剤、キレート剤および防食剤を含む。

【0047】

また、本実施の形態では、本発明の範囲内で、供給容器から供給される溶媒が、スラリ容器から供給されるスラリに含有される溶媒と、厳密に同じである必要はない。すなわち、本発明では、スラリの溶媒を測定用流体として用いるが、この溶媒が、研磨で使われるスラリと完全に同じ必要はない。研磨性能等への影響が抑えられる範囲で、例えば、濃度が多少異なってもよく、また、適当に異なる種類の溶媒も採用し得る。

【0048】

本実施の形態では、さらに、次の構成を適用することが好ましい。すなわち、本実施の形態では、供給路42を構成する部材が、耐薬品性の高い材料で構成される。排出路44を構成する部材も同様の材料で構成される。例えば、樹脂材またはセラミックが適用される。供給路が、耐薬品性の高い材料でコーティングさ

れてもよく、これも上記構成に含まれる。この構成によれば、測定用流体として用いる溶媒による供給路部材の損傷が防止される。また、溶媒の影響で供給路部材から溶出する不純物による基板の汚染が防止される。測定光および反射光を導く光ファイバについても同様の構成を採用することが望ましい。

【0049】

「実施の形態2」

次に、本発明の別の実施の形態について説明する。本実施の形態の基板研磨装置の構成は、図1～図3の上述の実施の形態と同様である。本実施の形態は、上述の実施の形態から、測定用流体が変更されている。

【0050】

すなわち、本実施の形態では、流体容器100は、測定用流体として、研磨のスラリと比べて高い粘度を有する高粘度流体を収容している。この高粘度流体が、供給ポンプ102により送出され、供給路42を通ってセンサ24に供給される。

【0051】

高粘度流体は研磨パッド18の貫通穴68（図2）へと噴出され、貫通穴68を満たす。高粘度流体は、研磨テーブル12と基板20の間から貫通穴68へと流入してくるスラリーを希釈する役割を果たし、また、基板20に付着しているスラリを洗浄する役割も果たす。このようにして、測定へのスラリの影響を低減し、要求される測定性能が確保できる。

【0052】

特に、上記のようにスラリより粘度の高い高粘度流体を使うと、貫通穴に流入してくるスラリの拡散が低減する。これにより、膜測定へのスラリの影響を低減し、測定性能を向上可能である。

【0053】

また、本実施の形態では、測定用流体として高粘度流体を使うので、研磨テーブル12と基板20の隙間への測定用流体の流出量を低減可能である。さらに、上記の拡散低減効果が得られるので、従来通常用いられる水よりも少ない供給量で同等の測定性能を得ることが可能になり、この点でも測定用流体の流出量を低

減可能と考えられる。そして、流出量の低減により、研磨性能への測定用流体の影響を低減できる。したがって、本実施の形態でも、測定性能を確保しつつ、研磨性能への測定用流体の影響を低減できる。

【0054】

本実施の形態に適用可能な高粘度流体は、例えば、エチレングリコールである。スラリの一般的な粘度が2 c p前後であるのに対し、エチレングリコールの粘度は、摂氏20度で23.5 c pであり、エチレングリコールの粘度がスラリの粘度より高い。特に、エチレングリコールは、ガラスに近い屈折率を有しており、本実施の形態のような光学測定に適しているといえる。また、高粘度流体はグリセリンでもよい。グリセリンの粘度は、摂氏20度で1499 c pである。また、高粘度流体としては、プロピレングリコール等の増粘剤が挙げられる。

【0055】

さらに、高粘度流体は、上述の溶媒の純水による希釀液でもよい。また、複数種類の流体が組み合わされてもよい。また、高粘度流体は、液体に限定されない。高粘度流体はゾル等でもよく、また、ゲルも本発明では高粘度流体に含まれてよい。

【0056】

また、本実施の形態では、既に説明したように、高粘度流体を供給するので、流体の流出量が少ない。そこで、本実施の形態では、排出のための構成が不要になる場合もある。高粘度流体の種類によっては、排出ポンプによる強制排出が行われなくてもよく、また、排出路が廃止されてもよい。

【0057】

「実施の形態3」

次に、本発明の別の実施の形態について説明する。本実施の形態の基板研磨装置の構成は、上述の実施の形態から、測定用流体が変更されている。

【0058】

すなわち、本実施の形態では、流体供給装置である供給管42は、測定用流体として気体を強制供給する。測定用の気体は、例えば、空気、窒素または希ガスである。この気体は、基板処理設備に備えられた配管からロータリージョイント

46を通って供給管42に供給されてもよい。この場合は、図1の流体容器100および供給ポンプ102は廃止され、基板処理設備のタンクとポンプが使われる。もちろん、基板研磨装置の近傍に図1の流体容器100と供給ポンプ102が配置されてもよい。この場合は気体用の容器とポンプが備えられる。さらには、排出用のポンプ48を廃止することも考えられる。供給および排出部分は、上記構成に限らず、気体の種類応じて適当に構成されてよい。また、本実施の形態で供給される気体は、もちろん、その湿度、圧力、コンタミネーション（汚染）が管理された気体である。

【0059】

既に説明したように、従来の流体式測定装置の提案では、測定用流体として、液体が強制供給されており、液体は通常は純水（D I W）であり、液体によりスラリが排除され、測定へのスラリの影響が軽減する。しかし、ある程度はスラリと液体が混ざるので、スラリの影響は依然として存在し、測定精度の低下の要因になる。

【0060】

本実施の形態は、上記の従来技術と異なり、測定用流体として気体を使うことを提案している。気体の供給により、スラリが測定部位から吹き飛ばされ、概ね排除されるので、精度の高い測定ができる。

【0061】

また、本実施の形態によれば、気体が流出してもスラリが希釈されないので、研磨性能への影響を低減できる。この観点において、本実施の形態も、測定性能を確保しつつ、研磨性能への測定用流体の影響を低減できる。

【0062】

また、本実施の形態は、測定用流体が液体ではないことから、投光部材および受光部材へのスラリ付着による測定精度への影響が懸念される。しかし、本実施の形態は、下記構成により、スラリの付着にも好適に対処できる。

【0063】

すなわち、本実施の形態においては、好ましくは、撥水処理を施した光ファイバが、投光用光ファイバ70および受光用光ファイバ72（図2）に適用される

。これにより、投光用光ファイバ70および受光用光ファイバ72が、撥水性のある部材で構成される。撥水処理は、少なくとも、光ファイバの先端付近の部分、特に、供給路42内に位置する部分に施されればよい。

【0064】

投光用光ファイバ70は、測定光を投光する投光部材であり、受光用光ファイバ72は、反射光を受光する受光部材である。これら部材が撥水性をもつことで、仮にスラリが付着しても、スラリは容易に排除される。

【0065】

また、供給路42、排出路44またはそれらの内面も、撥水性部材で構成してもよく、撥水コーティング処理を施してもよい。これにより、供給路42および排出路44へのスラリの付着を防ぐことができ、そして、供給口64および排出口68がスラリで塞がれるのを防止できる。また、供給路42等から投光用光ファイバ70および受光用光ファイバ72へのスラリの二次的付着も防止できる。

【0066】

また、本実施の形態の基板研磨装置において、流体の供給は以下のように制御されてもよい。ここでは、流体供給は研磨開始前から制御される。

【0067】

すなわち、前の基板の研磨またはドレッシングの後から次の研磨直前まで、間欠的に、または連続的に、供給路42から排出路44へ向けて、洗浄用流体として純水が供給される。そして、上述の実施の形態で説明したように、研磨中には測定用流体として気体が供給される。なお、上記の洗浄用流体の供給開始は、前の研磨またはドレッシングの終了前後の適当な時期でもよい。また、洗浄用の流体は、研磨が始まってから数秒が経過するまで供給されてもよい。要するに、流体供給装置により研磨前の期間を利用して洗浄用流体が供給されればよい。

【0068】

上記のような流体供給により、研磨中の測定を行う前から、センサ24(図1)の周辺を高度に清浄に保つことができる。研磨中に測定用流体として気体を供給した際に、高い測定性能を確保しつつ、研磨性能への測定用流体の影響を低減できる。上記の制御は、ドレッシング後の研磨時に特に有効であり、ドレッシン

グで生じる異物を効果的に排除できる。

【0069】

上記の流体制御において、洗浄用流体と測定用流体の組合せは変更されてよい。前者の洗浄用流体は、純水でもよく、また、上述の実施の形態で取り挙げた各種の流体、すなわち、スラリ溶媒、高粘度流体または気体でもよい。後者の測定用流体も、既に説明した通りに、スラリの溶媒でもよく、高粘度流体でもよく、気体でもよい。さらに、洗浄用流体と測定用流体は同じでもよく、異なってもよい。適用される流体を供給するために、流体に適合する配管等の装置が研磨テーブルに備えられる。このように洗浄用流体と測定用流体の組合せが変更されても、同様の効果が期待できる。

【0070】

また、上述の各種の実施の形態において、研磨パッド18は、発泡ウレタン製でもよく、不織布タイプまたはスエードタイプの研磨クロスでもよく、また、研磨砥粒をエポキシ等のバインダ剤で固めて形成した固定砥粒タイプのパッドでもよい。

【0071】

また、上述したすべての実施の形態において、測定用流体は、基板20の被測定面（照射面）、投光用光ファイバ70、受光用光ファイバ72、供給路42および排出路44の洗浄効果が上がるよう、清浄度が高く、純度が高い流体であることが好ましい。測定用流体が、フィルタを流路に設置することにより、測定用流体が濾過されてもよい。

【0072】

以上、本発明の好適な実施の形態を説明したが、本実施の形態は、本発明の範囲内で当業者が変形可能なことはもちろんである。

【0073】

【発明の効果】

本発明によれば、測定用流体としてスラリの溶媒が供給されるので、測定用流体が研磨テーブルに流出してスラリと混ざったとしても、スラリの希釈による研磨性能への影響を低減できる。したがって、測定能力を確保しつつ、研磨性能へ

の測定用流体の影響も低減できる。

【0074】

また、本発明によれば、高粘度流体が測定用流体として供給されるので、測定部位に流入するスラリの拡散を低減することができる。これにより、膜測定へのスラリの影響を低減し、測定性能を向上可能である。また、測定用流体の流出量を低減できるので、測定性能を確保しつつ、研磨性能への測定用流体の影響を低減できる。

【0075】

また、本発明によれば、測定用流体として気体を用いることによりスラリが測定部位から好適に排除され、良好な測定性能が得られる。気体が流出してもスラリが希釈されないので、研磨性能への測定用流体の影響を低減できる。したがって、測定性能を確保しつつ、研磨性能への測定用流体の影響を低減できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施の形態に係る基板研磨装置を示す図である。

【図2】

図1の基板研磨装置に備えられるセンサの構成例を示す図である。

【図3】

図1の基板研磨装置が備えられる基板処理装置を示す図である。

【符号の説明】

- 1 0 基板研磨装置
- 1 2 研磨テーブル
- 1 4 トップリング
- 1 6 研磨面
- 1 8 研磨パッド
- 2 0 基板
- 2 2 膜厚測定装置
- 2 4 センサ
- 2 6 電源ユニット

28 コントローラユニット
30 光源ユニット
32 フォトメータユニット
34 ロータリーコネクタ
36 光学的指標計算部
38 光学的指標判定部
40 研磨制御部
42 供給路
44 排出路
46 ロータリージョイント
48 ポンプ
50 並列部分
52 主流路
54 副流路
56, 58 供給制御弁
60 排出制御弁
62 ウォータージャケット
64 供給口
66 排出口
68 貫通穴
70 投光用光ファイバ
72 受光用光ファイバ
80 基板処理装置
82 基板カセット保持部
84 基板移動装置
86 洗浄室
88 作業用窓
90 ノズル
100 流体容器

102 供給ポンプ

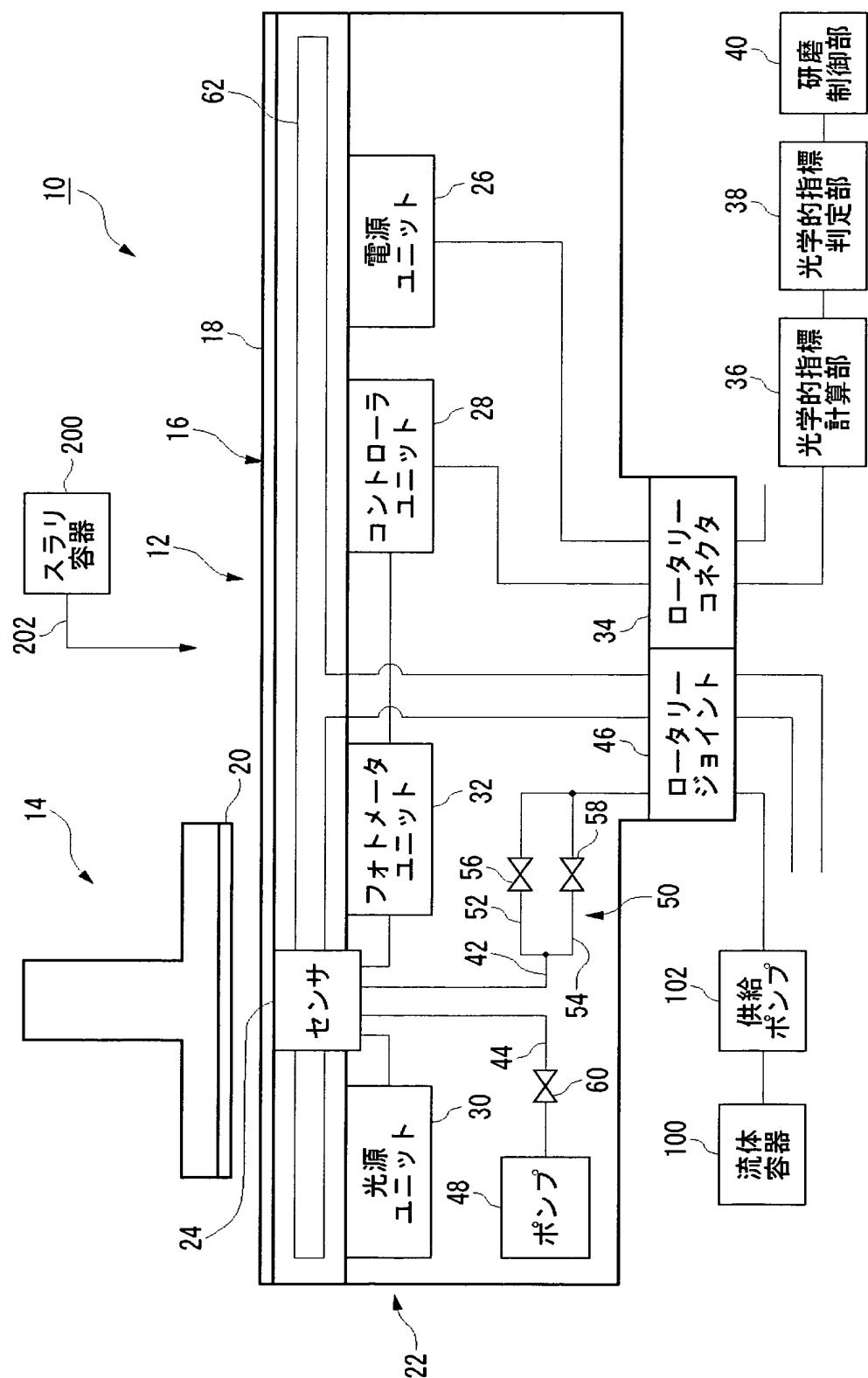
200 スラリ容器

202 スラリ供給路

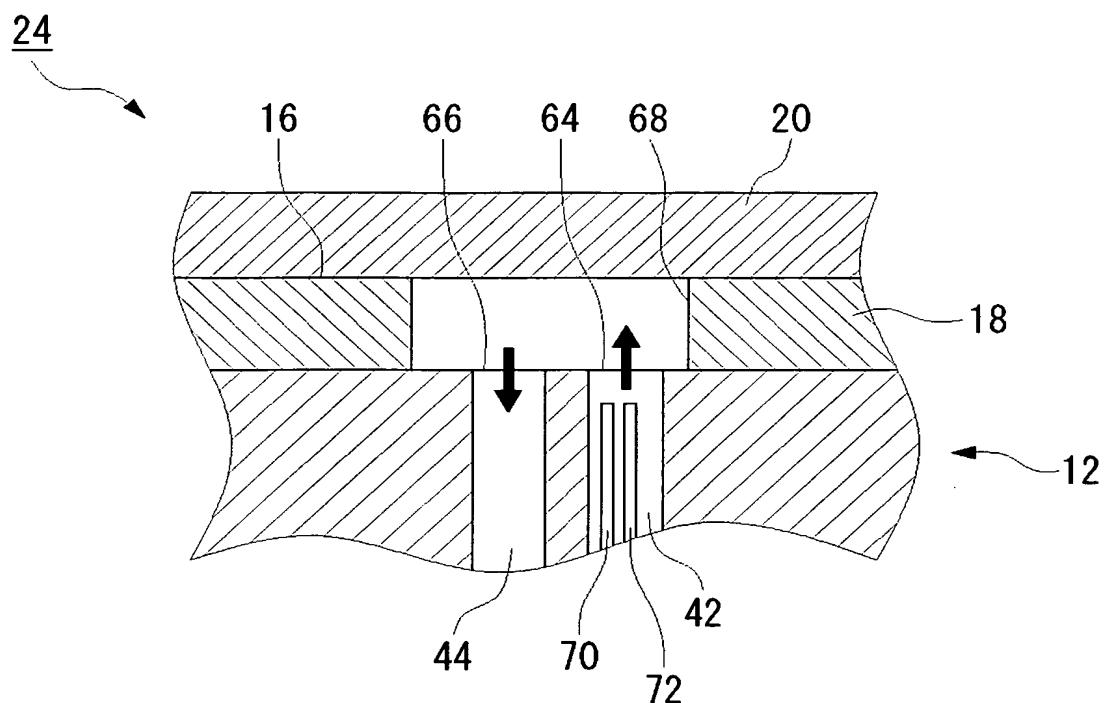
【書類名】

図面

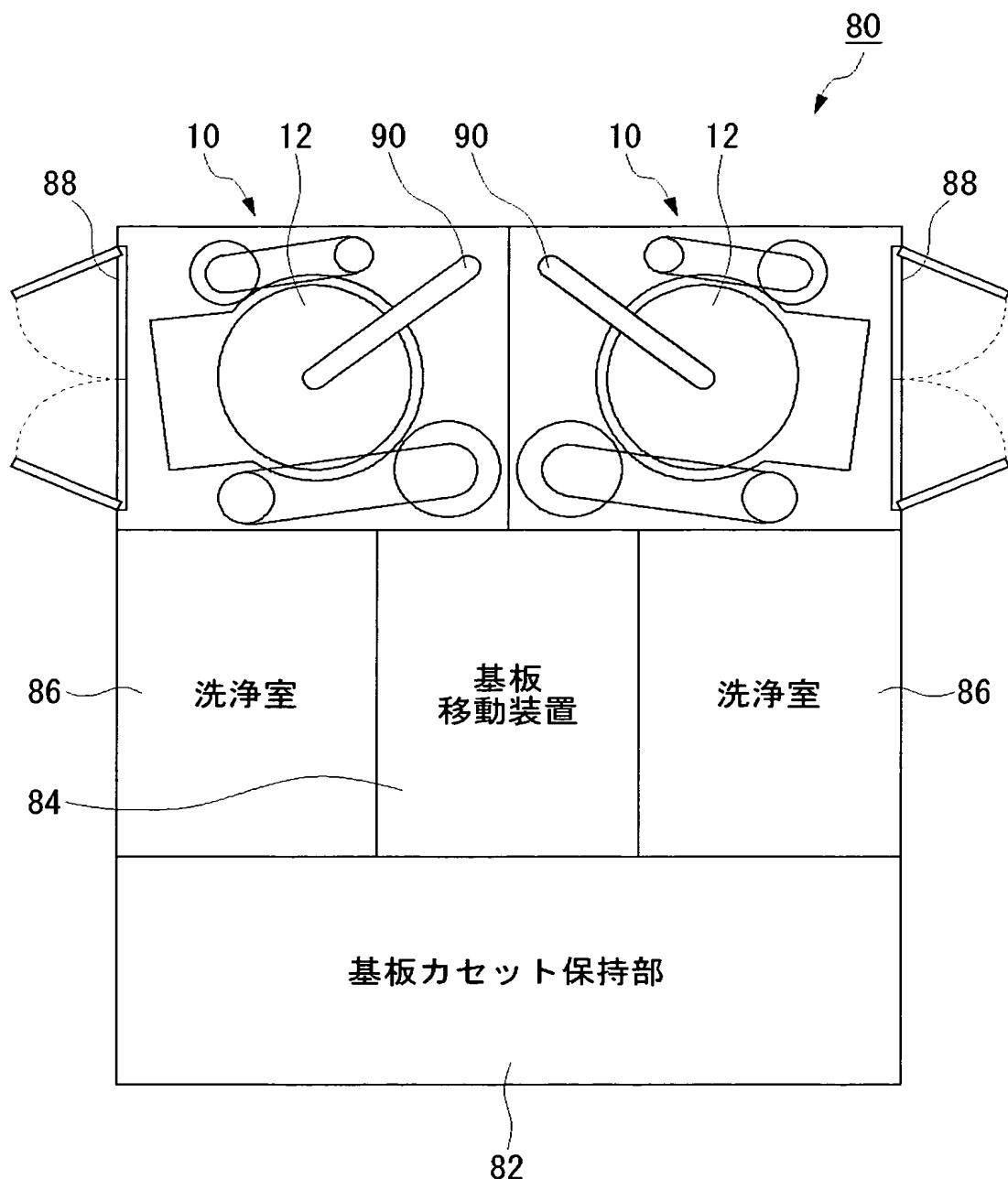
【図 1】



【図 2】



【図3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 測定性能を確保しつつ、研磨性能への測定用流体の影響を低減する。

【解決手段】 研磨テーブル12では、基板の膜測定のために、投光用光ファイバ70が測定光を基板20に投光し、受光用光ファイバ72が、基板20から反射光を受光する。測定光および反射光は、研磨パッド18の貫通穴68に供給管42から供給される測定用流体の中を通る。供給管42は、測定用流体として、研磨のスラリに用いられる溶媒を供給する。供給管42は、測定用流体として、研磨のスラリと比べて高い粘度を有する高粘度流体を供給してもよい。また、供給管42は、測定用流体として気体を供給してもよい。

【選択図】 図2

特願 2003-138496

出願人履歴情報

識別番号 [000000239]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都大田区羽田旭町11番1号
氏名 株式会社荏原製作所